

トランジスタ/Transistors

2SB1009

# 2SB1009

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ  
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.  
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistor

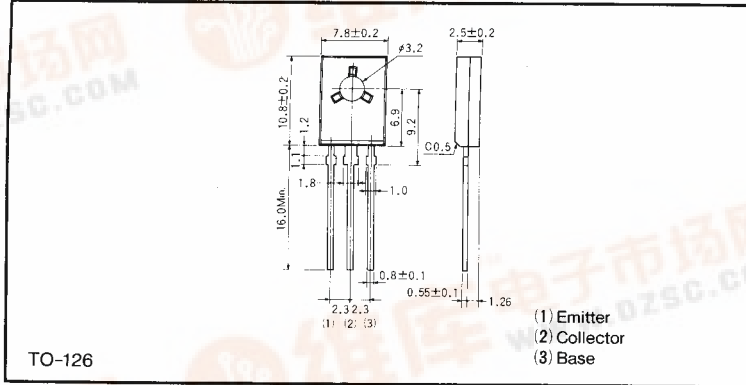
● 特長

- 1)  $V_{CE0} = -32V$ ,  $I_{CMax} = -2A$ ,  
 $P_{C MAX} = 10W$ の汎用タイプである。
- 2) 2SD1380とコンプリである。

● Features

- 1) General purpose design rated as  
 $V_{CE0} = -32V$ ,  $I_{CMax} = -2A$ ,  
 $P_{CMax} = 10W$
- 2) Complementary pair with 2SD1380.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ C$ )

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-32	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-2	A
		-3	A (Pulse)
コレクタ損失	$P_C$	10	W ( $T_c = 25^\circ C$ )
		1.2	W ( $T_a = 25^\circ C$ )
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度範囲	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$

● 電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ C$ )

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$BV_{CEO}$	-32	-	-	V	$I_C = -1mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	$BV_{CBO}$	-40	-	-	V	$I_C = -50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	$BV_{EBO}$	-5	-	-	V	$I_E = -50\mu A$
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	-	-	-1	$\mu A$	$V_{CB} = -20V$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	-	-	-1	$\mu A$	$V_{EB} = -4V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	-	-0.5	-0.8	V	$I_C / I_E = -2A / -0.2A$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	82	-	390	-	$V_{CE} / I_C = -5V / -0.5A$
利得帯域幅積	$f_T$	-	100	-	MHz	$V_{CE} = -5V, I_E = 0.5A$
出力容量	$C_{ob}$	-	50	-	pF	$V_{CB} = -10V, I_E = 0A, f = 1MHz$

$h_{FE}$ の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
$h_{FE}$	82~180	120~270	180~390

● 標準品・準標準品一覧表

(◎: 標準品 ○: 準標準品)

Type	$h_{FE}$	包装名	バルク
2SB1009	PQR	記号	
		基本発注単位(個)	1 000
			◎

